

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年7月21日(2005.7.21)

【公開番号】特開2003-229610(P2003-229610A)

【公開日】平成15年8月15日(2003.8.15)

【出願番号】特願2002-25398(P2002-25398)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 39/24

H 01 L 39/22

【F I】

H 01 L 39/24 Z A A J

H 01 L 39/22 A

【手続補正書】

【提出日】平成16年11月26日(2004.11.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板表面上にc軸配向の下部電極用酸化物超電導膜を形成し、パターニングした後に層間絶縁膜を形成し、下部電極用酸化物超電導膜上の層間絶縁膜の一部をエッチングし層間絶縁膜の孔明け部分を形成し、その後、障壁層用薄膜と、c軸配向の上部電極用酸化物超電導膜とを形成して、基板に接合部を形成する酸化物超電導接合基板の製造方法。

【請求項2】

層間絶縁膜の孔明け部分を形成する際に下部電極用酸化物超電導膜の表面のエッチングを行ない、熱処理し、障壁層用薄膜を形成する請求項1に記載の酸化物超電導接合基板の製造方法。